

Билеты по курсу  
«Физика конденсированного состояния»

Google Gemini 3 Pro                   Андрей Можаров

27 января 2026 г.

# Оглавление

<b>Билет №1</b>	<b>4</b>
1    Принцип запрета Паули и свойства идеального газа свободных электронов в основном состоянии. . . . .	4
1.1    Введение: Модель свободных электронов (Квантовая теория Зоммерфельда) . . . . .	4
1.2    Принцип запрета Паули . . . . .	4
1.3    Основное состояние ( $T = 0$ ) . . . . .	4
2    Теорема о связи семейств атомных плоскостей с векторами обратной решётки. . . . .	5
2.1    Основные определения . . . . .	5
2.2    Формулировка теоремы . . . . .	6
2.3    Доказательство . . . . .	6
<b>Билет №2</b>	<b>7</b>
1    Температурное разложение Зоммерфельда. Расчёт удельной теплоёмкости вырожденного электронного газа. . . . .	7
2    Кристаллические структуры и решётки с базисом. Примитивная (элементарная) ячейка, ячейка Вигнера-Зейтца и условная ячейка. . . . .	7
<b>Билет №3</b>	<b>8</b>
1    Магнетизм электронного газа. Теорема Бора - Ван Леевен. . . . .	8
2    Приближение почти свободных электронов: теория возмущений по слабому периодическому псевдопотенциалу, поведение уровней энергии вблизи брэгговских плоскостей. . . . .	8
<b>Билет №4</b>	<b>9</b>
1    Магнитная восприимчивость больцмановского газа электронов с учётом их собственного магнитного момента. Закон Кюри. . . . .	9
2    Решётка Бравэ и её свойства. . . . .	9
<b>Билет №5</b>	<b>10</b>
1    Парамагнетизм вырожденного электронного газа, связанный с существованием собственного магнитного момента у электрона (парамагнетизм Паули). .	10
2    Гексагональная плотноупакованная структура. . . . .	10
<b>Билет №6</b>	<b>11</b>
1    Электро- и теплопроводность металлов: закон Ома; температурная зависимость удельного сопротивления; закон Фурье; коэффициент теплопроводности; закон Видемана-Франца. . . . .	11
2    Границные условия Борна-Кармана для блоховских электронов и число разрешённых значений квазимпульса. Критерии металла и изолятора. . . . .	11
<b>Билет №7</b>	<b>12</b>

1	Простая, объёмно-центрированная и гранецентрированная кубические решётки. . . . .	12
2	Статическая электропроводность металлов в рамках квантовой модели свободных электронов Зоммерфельда. . . . .	12
<b>Билет №8</b>		<b>13</b>
1	Структуры типа хлорида натрия, алмаза и цинковой обманки. . . . .	13
2	Коэффициент теплопроводности металлов в рамках квантовой модели свободных электронов Зоммерфельда. Закон Видемана- Франца. . . . .	13
<b>Билет №9</b>		<b>14</b>
1	Координационное число и коэффициент компактности (упаковочный множитель). Алгоритм построения различных плотноупакованных структур. . . . .	14
2	Решение уравнения Больцмана в пределе малых градиентов электрического потенциала и температуры. Транспортное время свободного пробега электронов. . . . .	14
<b>Билет №10</b>		<b>15</b>
1	Поворотные оси симметрии. Теорема о симметрии кристаллических решёток по отношению к поворотам. . . . .	15
2	Общая структура и свойства интеграла столкновений. Принцип детального баланса. . . . .	15
<b>Билет №11</b>		<b>16</b>
1	Обратная решётка и её свойства. Обратные решётки для г.ц.к. и о.ц.к. решёток. . . . .	16
2	Эффект Зеебека. Оценка дифференциальной термо-э.д.с. металлов в рамках элементарной кинетической теории Друде. . . . .	16
<b>Билет №12</b>		<b>17</b>
1	Электропроводность металла под действием нестационарного, но однородного электрического поля в модели свободных электронов Друде. . . . .	17
2	Разрешённые и запрещённые энергетические зоны в кристаллах. Отсутствие вклада в электрический ток от полностью заполненных зон (инертность заполненных зон). Критерии металла и диэлектрика. . . . .	17
<b>Билет №13</b>		<b>18</b>
1	Теорема Блоха о виде волновой функции электрона в периодическом потенциале. Квазимпульс и его свойства. . . . .	18
2	Теория электропроводности металлов Друде. Среднее время и средняя длина свободного пробега. . . . .	18
<b>Билет №14</b>		<b>19</b>
1	Определение собственного и орбитального магнитного моментов электрона. Намагниченность и магнитная восприимчивость электронного газа. Диамагнетизм и парамагнетизм. . . . .	19
2	Теорема о средней скорости блоховского электрона. . . . .	19
<b>Билет №15</b>		<b>20</b>
1	Плотность одноэлектронных уровней энергии в модели свободных электронов Зоммерфельда. Расчёт температурной зависимости химического потенциала для сильно вырожденного электронного газа. . . . .	20

2	Геометрические формулировки условий конструктивной интерференции рентгеновских лучей в кристалле: построения Бриллюэна и Эвальда. . . . .	20
<b>Билет №16</b>		<b>21</b>
1	Принцип запрета Паули и волновая функция невзаимодействующих электронов. Модель свободных электронов Зоммерфельда. . . . .	21
2	Экспериментальные методы определения кристаллических структур: метод Лауэ, метод вращающегося кристалла, порошковый метод (метод Дебая-Шерпера). . . . .	21
<b>Билет №17</b>		<b>22</b>
1	Условия конструктивной интерференции рентгеновских лучей в кристалле в формулировках Брэгга и Лауэ. Доказательство эквивалентности этих формул. . . . .	22
2	Распределение Ферми-Дирака. Температура Ферми, химический потенциал и условие вырождения электронного газа. . . . .	22
<b>Билет №18</b>		<b>23</b>
1	Теория теплопроводности металлов Друде. Закон Видемана-Франца в рамках модели Друде. . . . .	23
2	Геометрический структурный фактор кристаллических структур. . . . .	23
<b>Билет №19</b>		<b>24</b>
1	Агрегатные состояния и термодинамические фазы вещества. Фазовые переходы, критические точки, полиморфизм. . . . .	24
2	Расчёт дифференциальной термо-э.д.с. металлов в рамках кинетического уравнения Больцмана. . . . .	24
<b>Билет №20</b>		<b>25</b>
1	Атомные плоскости и семейства атомных плоскостей. Индексы Миллера и их геометрическая интерпретация. . . . .	25
2	Свойства энергетического спектра электронов вблизи экстремумов энергии в зоне Бриллюэна. Тензор обратных эффективных масс блоховского электрона и его свойства. . . . .	25
<b>Билет №21</b>		<b>26</b>
1	Количественный критерий принадлежности твёрдого тела к металлу или диэлектрику. Диэлектрики, полупроводники, металлы и полуметаллы. . . .	26
2	Эффективные массы блоховских электронов в двузонной модели. . . . .	26

# Билет №1

## 1 Принцип запрета Паули и свойства идеального газа свободных электронов в основном состоянии.

### 1.1 Введение: Модель свободных электронов (Квантовая теория Зоммерфельда)

В отличие от классической теории Друде, теория Зоммерфельда рассматривает электроны как **квантовый газ**, подчиняющийся статистике Ферми-Дирака.

- «**Свободные**» означает, что потенциальная энергия взаимодействия электрона с ионами решетки и другими электронами полагается равной нулю ( $U = 0$ ).
- Электроны находятся в потенциальном ящике объемом  $V$  (кристалл).

### 1.2 Принцип запрета Паули

Это фундаментальное положение, определяющее поведение электронной системы.

- **Суть:** Электроны являются фермионами (спин  $s = 1/2$ ). Согласно принципу Паули, в одном квантовом состоянии не может находиться более одного фермиона.
- **Квантовое состояние:** Характеризуется волновым вектором  $\vec{k}$  и проекцией спина  $\sigma$  ( $\uparrow$  или  $\downarrow$ ). Следовательно, каждое пространственное состояние  $\vec{k}$  может быть занято **не более чем двумя** электронами (с противоположными спинами).

### 1.3 Основное состояние ( $T = 0$ )

«Основное состояние» означает состояние системы при абсолютном нуле температуры. В классической физике энергия всех частиц была бы равна нулю. В квантовой физике из-за принципа Паули это невозможно: электроны вынуждены заполнять энергетические уровни, начиная с нижнего, "этаж за этажом".

#### Сфера Ферми и волновой вектор Ферми

Разрешенные значения волнового вектора определяются граничными условиями Борна-Кармана (периодическими):

$$k_{x,y,z} = \frac{2\pi}{L} n_{x,y,z} \quad \text{где } n_i \text{ — целые числа}$$

В  $k$ -пространстве одно разрешенное значение  $\vec{k}$  занимает объем  $(2\pi L)^3 = 8\pi^3/V$ .

При  $T = 0$   $N$  электронов заполняют сферу в пространстве импульсов (сферу Ферми) радиуса  $k_F$ . Объем этой сферы  $\Omega = 4/3\pi k_F^3$ .

Число электронов  $N$  в объеме  $V$  связано с  $k_F$  формулой (учитываем фактор 2 за счет спина):

$$N = 2 \cdot \frac{V_{\text{сфера}}}{V_{\text{на одно состояние}}} = 2 \cdot \frac{4/3\pi k_F^3}{(2\pi)^3/V} = \frac{V k_F^3}{3\pi^2}$$

Отсюда выводится важнейшее соотношение для концентрации электронов  $n = N/V$ :

$$n = \frac{k_F^3}{3\pi^2} \Rightarrow k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$$

## Энергия Ферми

Энергия электрона с волновым вектором  $\vec{k}$  равна:

$$\varepsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Максимальная энергия занятого состояния при  $T = 0$  называется **энергией Ферми**:

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

*Физический смысл:* Это химический потенциал системы при  $T = 0$ . Все состояния с  $\varepsilon < \varepsilon_F$  заняты, а с  $\varepsilon > \varepsilon_F$  свободны.

*Порядок величины:* Для металлов  $\varepsilon_F$  составляет несколько электрон-вольт (1.5–10 эВ), что соответствует гигантской «температуре Ферми»  $T_F = \varepsilon_F/k_B \approx 10^4 - 10^5$  К.

## Полная и средняя энергия

Даже при абсолютном нуле электронный газ обладает огромной энергией. Полная энергия  $E$  получается суммированием энергий всех электронов внутри сферы Ферми (интегрированием по слоям сферы):

$$E = 2 \sum_{k < k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

В Ашкрофте-Мермине (Том 1, стр. 47) приводится знаменитый результат для средней энергии на один электрон:

$$\frac{E}{N} = \frac{3}{5} \varepsilon_F$$

Это означает, что средняя энергия электрона составляет 60% от максимальной.

## Давление вырожденного газа

Из-за высокой кинетической энергии электронный газ оказывает давление на стенки кристалла, даже если температура равна нулю. Это давление (давление вырождения) можно получить из термодинамического соотношения  $P = -(\partial E / \partial V)_N$ .

$$P = \frac{2}{3} \frac{E}{V} = \frac{2}{3} n \cdot \frac{3}{5} \varepsilon_F = \frac{2}{5} n \varepsilon_F$$

Именно это давление удерживает кристалл от сжатия (противодействует притяжению ионов).

## 2 Теорема о связи семейств атомных плоскостей с векторами обратной решётки.

### 2.1 Основные определения

- **Обратная решётка:** Множество векторов  $\mathbf{K}$ , удовлетворяющих условию  $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1$  для любого вектора прямой решётки Бравэ  $\mathbf{R}$ .
- **Семейство атомных плоскостей:** Набор параллельных, равноотстоящих плоскостей, которые содержат все узлы решётки Бравэ.

- **Индексы Миллера**  $(h, k, l)$ : Три целых числа (взаимно простых), определяющих ориентацию плоскости. Плоскость пересекает оси примитивных векторов  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$  в точках  $x_1\mathbf{a}_1, x_2\mathbf{a}_2, x_3\mathbf{a}_3$ , где отрезки отсечения обратно пропорциональны индексам:

$$x_1 : x_2 : x_3 = \frac{1}{h} : \frac{1}{k} : \frac{1}{l}$$

## 2.2 Формулировка теоремы

Для любого семейства плоскостей решетки, отстоящих друг от друга на расстояние  $d$  и определяемых индексами Миллера  $(h, k, l)$ , существует вектор обратной решетки  $\mathbf{K}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$ , такой что:

1. Вектор  $\mathbf{K}_{hkl}$  перпендикулярен плоскостям этого семейства.
2. Длина вектора  $|\mathbf{K}_{hkl}|$  связана с межплоскостным расстоянием формулой:

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\mathbf{K}_{hkl}|}$$

## 2.3 Доказательство

### Доказательство перпендикулярности ( $\mathbf{K} \perp$ плоскости)

Рассмотрим плоскость, проходящую через точки пересечения с осями:  $\mathbf{a}_1/h, \mathbf{a}_2/k, \mathbf{a}_3/l$ . Построим два вектора, лежащих в этой плоскости:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{a}_1}{h} - \frac{\mathbf{a}_2}{k}, \quad \mathbf{v} = \frac{\mathbf{a}_1}{h} - \frac{\mathbf{a}_3}{l}$$

Вычислим скалярное произведение вектора обратной решетки  $\mathbf{K} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$  с вектором  $\mathbf{u}$ , используя соотношение  $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{K} \cdot \mathbf{u} &= (h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3) \cdot \left( \frac{\mathbf{a}_1}{h} - \frac{\mathbf{a}_2}{k} \right) \\ &= h \frac{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1}{h} - k \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_2}{k} = 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$

Аналогично  $\mathbf{K} \cdot \mathbf{v} = 0$ . Так как  $\mathbf{K}$  перпендикулярен двум не коллинеарным векторам в плоскости, он перпендикулярен самой плоскости.

### Доказательство формулы для расстояния $d$

Расстояние от начала координат до ближайшей плоскости (являющееся также межплоскостным расстоянием  $d$ ) равно проекции любого вектора, соединяющего начало координат с точкой на плоскости, на направление нормали  $\mathbf{n}$ .

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{K}}{|\mathbf{K}|}$$

В качестве точки на плоскости выберем пересечение с осью  $\mathbf{a}_1$ :  $\mathbf{r} = \mathbf{a}_1/h$ .

$$d = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r} = \frac{\mathbf{K}}{|\mathbf{K}|} \cdot \frac{\mathbf{a}_1}{h}$$

Раскрывая  $\mathbf{K}$ :

$$d = \frac{(h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3) \cdot \mathbf{a}_1}{h|\mathbf{K}|} = \frac{h(\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1)}{h|\mathbf{K}|} = \frac{2\pi}{|\mathbf{K}|}$$

*Что и требовалось доказать.*

## Билет №2

- 1 Температурное разложение Зоммерфельда. Расчёт удельной теплоёмкости вырожденного электронного газа.
- 2 Кристаллические структуры и решётки с базисом. Примитивная (элементарная) ячейка, ячейка Вигнера-Зейтца и условная ячейка.

## Билет №3

- 1 Магнетизм электронного газа. Теорема Бора - Ван Леевен.
- 2 Приближение почти свободных электронов: теория возмущений по слабому периодическому псевдопотенциальному, поведение уровней энергии вблизи брэгговских плоскостей.

## Билет №4

- 1 Магнитная восприимчивость больцмановского газа электронов с учётом их собственного магнитного момента.  
Закон Кюри.
- 2 Решётка Бравэ и её свойства.

## Билет №5

- 1 Парамагнетизм вырожденного электронного газа, связанный с существованием собственного магнитного момента у электрона (парамагнетизм Паули).
- 2 Гексагональная плотноупакованная структура.

## Билет №6

- 1 Электро- и теплопроводность металлов: закон Ома; температурная зависимость удельного сопротивления; закон Фурье; коэффициент теплопроводности; закон Видемана-Франца.
- 2 Границные условия Борна-Кармана для блоховских электронов и число разрешённых значений квазипульса. Критерии металла и изолятора.

## Билет №7

- 1 Простая, объёмно-центрированная и гранецентрированная кубические решётки.
- 2 Статическая электропроводность металлов в рамках квантовой модели свободных электронов Зоммерфельда.

## Билет №8

- 1 Структуры типа хлорида натрия, алмаза и цинковой обманки.
- 2 Коэффициент теплопроводности металлов в рамках квантовой модели свободных электронов Зоммерфельда. Закон Видемана- Франца.

## Билет №9

- 1 Координационное число и коэффициент компактности (упаковочный множитель). Алгоритм построения различных плотноупакованных структур.
- 2 Решение уравнения Больцмана в пределе малых градиентов электрического потенциала и температуры. Транспортное время свободного пробега электронов.

# Билет №10

- 1 Поворотные оси симметрии. Теорема о симметрии кристаллических решёток по отношению к поворотам.
- 2 Общая структура и свойства интеграла столкновений. Принцип детального баланса.

## Билет №11

- 1 Обратная решётка и её свойства. Обратные решётки для г.ц.к. и о.ц.к. решёток.
- 2 Эффект Зеебека. Оценка дифференциальной термо-Э.Д.С. металлов в рамках элементарной кинетической теории Друде.

## Билет №12

- 1 Электропроводность металла под действием нестационарного, но однородного электрического поля в модели свободных электронов Друде.
- 2 Разрешённые и запрещённые энергетические зоны в кристаллах. Отсутствие вклада в электрический ток от полностью заполненных зон (инертность заполненных зон). Критерии металла и диэлектрика.

## Билет №13

- 1 Теорема Блоха о виде волновой функции электрона в периодическом потенциале. Квазимпульс и его свойства.
- 2 Теория электропроводности металлов Друде. Среднее время и средняя длина свободного пробега.

## Билет №14

- 1 Определение собственного и орбитального магнитного моментов электрона. Намагниченность и магнитная восприимчивость электронного газа. Диамагнетизм и парамагнетизм.
- 2 Теорема о средней скорости блоховского электрона.

## Билет №15

- 1 Плотность одноэлектронных уровней энергии в модели свободных электронов Зоммерфельда. Расчёт температурной зависимости химического потенциала для сильно вырожденного электронного газа.
- 2 Геометрические формулировки условий конструктивной интерференции рентгеновских лучей в кристалле: построения Бриллюэна и Эвальда.

## Билет №16

- 1 Принцип запрета Паули и волновая функция невзаимодействующих электронов. Модель свободных электронов Зоммерфельда.
- 2 Экспериментальные методы определения кристаллических структур: метод Лауэ, метод вращающегося кристалла, порошковый метод (метод Дебая-Шеррера).

## Билет №17

- 1 Условия конструктивной интерференции рентгеновских лучей в кристалле в формулировках Брэгга и Лауэ. Доказательство эквивалентности этих формулировок.
- 2 Распределение Ферми-Дирака. Температура Ферми, химический потенциал и условие вырождения электронного газа.

## Билет №18

- 1 Теория теплопроводности металлов Друде. Закон Видемана-Франца в рамках модели Друде.
- 2 Геометрический структурный фактор кристаллических структур.

# Билет №19

- 1 Агрегатные состояния и термодинамические фазы вещества. Фазовые переходы, критические точки, полиморфизм.
- 2 Расчёт дифференциальной термо-Э.д.с. металлов в рамках кинетического уравнения Больцмана.

# Билет №20

- 1 Атомные плоскости и семейства атомных плоскостей. Индексы Миллера и их геометрическая интерпретация.
- 2 Свойства энергетического спектра электронов вблизи экстремумов энергии в зоне Бриллюэна. Тензор обратных эффективных масс блоховского электрона и его свойства.

## Билет №21

- 1 Качественный критерий принадлежности твёрдого тела к металлу или диэлектрику. Диэлектрики, полупроводники, металлы и полуметаллы.
- 2 Эффективные массы блоховских электронов в двухзонной модели.